第13卷 第11期

GGG(Ca,Mg,Zr):(Nd,Cr) 激光新晶体 的生长及测试

荀大敏

(天津市科技进修学院天津光电技术研究所)

朱化南 靳福慧 刘海润 张乐惠

(中国科学院物理研究所)

提要: 报道了双掺钕铬的钙镁锆钆镓石榴石单晶的生长及激光性能。用提拉法、高频感应加热、铱坩埚成功地生长出尺寸为 ϕ 18×60~80 mm 完整透明的晶体毛坯,并加工成 ϕ 5×40 mm 的激光棒。得到的激光输出斜率效率达0.7%。 讨论了晶体的光谱性能和晶格常数的测定及与置换少量 Se 的双掺钕铬晶体GGG(Se): (Nd, Cr)的一些对比实验结果。

Growth and measurement of GGG (Ca, Mg, Zr): (Nd, Cr) laser crystals

Xun Damin

(Tianjin Institute for Advanced Studies of Science and Technology, Research Institute of Photoelectric Techniques)

Zhu Huanan, Jin Fuhui, Liu Hairun, Zhang Lehui
(Institute of Physics, Academia Sinica)

Abstract: Gadolium gallium garnet crystals substituted with Ca,Mg, and Zr and doubly-doped with Nd and Cr are grown, and their laser properties are investigated. Transparent and perfect boules measuring $\varphi 18 \times 60 \sim 80$ mm are grow n by means of Czochralski method using iridium crucible and inducting heating. Laser rods of the size of $\varphi 5 x$ 40mm are machined. The output slope efficiency obtained was 0.7. Comparison of spectroscopic properties and lattice constant of the crystal with those of GGG crystals doubly doped with Nd, Cr and substituted with a small amount of Sc is made and a discussion is given.

一、引言

目前, YAG: Nd 晶体是国内外最通用的

固体激光材料之一。但 YAG 中掺 Nd 量由于受到浓度猝灭和基质晶体结构的影响而无法增加。 故要显著地提高 YAG: Nd 晶体的

收稿日期: 1985年8月3日。

激光效率,已是很困难的事。

苏联列别捷夫研究所最近报道了GSGG: (Nd、Cr)^[11](掺钕铬的钆钪镓石榴石)的生长研究和激光性能。报道的激光棒尺,寸为φ5×50 mm,激光效率为 YAG:Nd 的 2.4 倍。西德的 D、Pruss'^[21]等人也有关于该晶体的报道。他们用氮激光抽运片状晶体,采用纵向抽运方式,Nd 的激光效率达 36%。

我们在生长 GGG:Nd 和 GGG:(Nd、Cr)晶体工作的基础上,进行了 GGG(Se):(Nd、Cr)和 GGG(Ca、Mg、Zr):(Nd、Cr)晶体的生长研究。由于 Se 的价格昂贵,因此,想以Mg²⁺、Zr⁴⁺ 替代 Se³⁺ 进入石榴石的八面体,而以 Ca²⁺ 代替部分 Gd³⁺ 作为价态补偿之用,另外也做了掺少量 Se 的生长试验,以作对比。

1. 原料制备

我们使用的原料纯度如下: Ga_2O_35N ; Gd_2O_34N ; Nd_2O_3 为光谱纯外, 其它均为分析纯。

两种晶体的分子式分别为:

$$Gd_{3-x}Nd_{x}Ga_{2-y-z}Cr_{y}Se_{z}Ga_{3}O_{12}$$
(1)
$$Gd_{3-x-t}Nd_{x}Ca_{t}Ga_{2-y-z-q}Cr_{y}Mg_{z}Zr_{q}Ga_{3}O_{12}$$

将称好的原料放入玛瑙研钵,研磨 2~3 小时,使其成为细粉末并混合均匀。然后装入洗净的乳胶袋中,按坩埚形状初步成型。最后送入等面静压 机中,在 2000 kg/cm²的压力下使原料固化。固化后的原料再经 1200℃的高温灼烧 4 小时进行固相反应。这种烧好的原料即可供晶体生长使用。

2. 晶体生长

采用提拉法,高频感应加热,铱金坩埚。 其工艺装置由图1给出。

晶体生长是在流动的氮气和氧气的混合气氛中进行, Na 气的流量为 1500 ml/min,

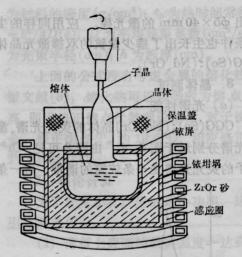


图 1 应用提拉法生长 GGG (Ca, Mg, Zr): (Nd, Cr)单晶的装置示意图

O₂ 气的流量为氮气流量的 2%。这与 GGG: Nd^[33]、 GGG: (Nd、Cr)^[43] 的生长方法基本相同。

氧气中杂质和水份对坩埚有一定的作用,影响晶体的质量。 将工业氧经氧气净化器净化后再充入炉体,生长出的晶体质量明显提高。 经切片在显微镜下观察,晶体等径部分基本看不到铱金包裹物。

采用慢转速放肩,一般为14~18转/min。拉速为3~4mm/h。这样可保持尖界面生长,有利于排除位错。放肩到一定直径后,停拉恒温一小时,然后加快转速至40~60转/min,使界面发生反转,原有的尖界面充分熔融。 待固液界面反转稳定后,便可开始等径生长。 实验采用的等径 拉速为 2~4 mm/h。 按以上工艺,我们已生长出 \$\phi16~18×60~80 mm 的 GGG(Ca、Mg、Zr):(Nd、Cr)晶体,见图 2 所示。晶体完整透明,并加



mm 007 000 8 2 mm TEX-1644

工出 ϕ 5×40 mm 的激光棒。 应用同样的生长条件也生长出了掺少量钪的双掺激光晶体 GGG(So):(Nd, Cr)。

3. 晶体测试

(a) 光谱性能

GGG(Se):(Nd、Cr)晶体的荧光光谱、激发光谱分别示于图 3、4。 由图 3 可见, Cr³⁺ 离子的荧光光谱是一条较宽的谱带, 这一条

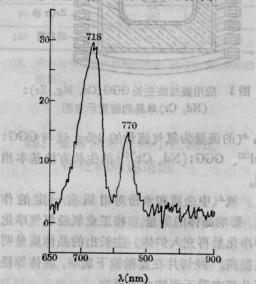


图 3 GGG(Se):(Nd、Cr)晶体 的荧光光谱示意图

λ_{EX}—476 nm; λ_{EM}—650~900 nm

20

10

400 500 600. 700

图 4 GGG(Se):(Nd、Cr)晶体 的激发光谱示意图

 λ_{EM} -717 nm; λ_{EX} -390~700 nm

峰值在 718 nm 处,这个谱带与 Cr³+ 离子由
"T₂ 激发态向 ⁴A₂ 基态跃迁有关。图 4 给 出了晶体的激发光谱,470 nm 及 625 nm 两个谱带对应 ⁴A₂→→⁴T₁和 ⁴T₂的跃迁。
GGG(Sc):(Nd、Cr)和 GGG(Ca、Mg、Zr):(Nd、Cr)晶体的吸收光谱在图 5、图 6 中给 出。测试用的样品为 1.2 mm 厚两面抛光晶片,图 5、6 中曲线 II 是经 30 W 紫外灯直接 辐照 10 小时的样品。Cr 的吸收带最大值在 450 nm 和 640 nm 处,复盖了大部分可见光谱区。而钕的谱线较窄。这样抽运光在可见光谱区。而钕的谱线较窄。这样抽运光在可见光谱区,而钕的能量将大部分由 Cr³+ 离子吸收转移给 Nd³+,大大提高了抽运效率。

(b) 晶格常数 (b) 台灣 智力 (b) 周期

用 JF-1 型 x 光机, 计算器衍射仪测定 了GGG(Se):(Nd、Cr)和 GGG(Ca、Mg、Zr): (Nd、Cr)晶体的晶格常数 a₀, 结果列于表 1。

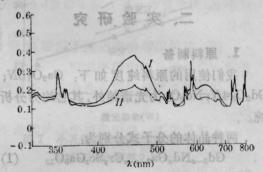


图 5 GGG(Se):(Nd、Cr)晶体的吸收光谱 I—未经辐照的样品; II—经 30 W 紫外灯辐照的样品

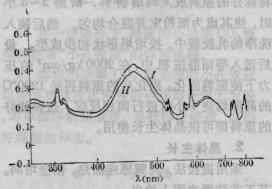


图 6 GGG(Ca、Mg, Zr):(Nd, Cr) 晶体的吸收光谱

I一未经辐照的样品; II—经 30 W 紫外灯辐照的样品

晶	体	GGG(Sc):(Nd,Cr)	GGG(Ca,Mg,Zr):(Nd,Cr)*	GGG	YAG
a ₀ (1	ım)	1.2385	1.2500	1.2380	1.2001

* GGG (Ca, Mg, Zr): (Nd, Cr)的化学分析结果平均值(重量%)如下:
Nd₂O₃ 0.82 CaO 1.67 ZrO₂ 5.61 Cr₂O₃ 0.12 MgO 0.54

(c) 激光性能

将 ϕ 5×40 mm 的 GGG(Ca、Mg、Zr): (Nd、Cr)棒(端面与棒轴线垂直,未镀增透膜)置于单椭圆 玻璃聚 光器内,用 ϕ 7×70 mm 滤紫外直管脉冲氙灯抽运,使其在平平 谐振腔中产生静态激光振荡。当输出端镜片透过率为 30% 时,激光输出的斜率效率可达 0.7%,阈值为 6J。在同一激光装置中的 ϕ 5×30 mm 的 GGG:(Nd、Cr)的激光斜率 仅为 0.2%。

另外将 GGG(Ca、Mg、Zr):(Nd、Cr)激 光棒作消光比的测定,发现其仅为 9dB,说 明在提高晶体的质量方面尚有潜力。

124 in crystal ErPsO: were calculated by cillator strengt, spotting zadiative

(a) 晶格常数对 Nd³+、Cr³+ 在晶体中 分布的影响

在 GGG 基质晶体中掺入 Se3+ 和 Ca2+、 Mg2+、Zr4+ 这些大直径离子的目的是为了扩 大晶胞, 改善 Nd3+ 和 Cr3+ 离子在晶体中的 分凝系数。 这在文献中已有报道。 在 GGG 晶体中 Nd 的分凝系数为 0.5^[8]。 而在 GSG G 晶体中, Nd 的分凝系数为 0.76^[5]。 Cr 的 分凝系数接近于 1^[6]。 这样便解决了 YAG 晶体因分凝系数太小, Nd 离子不易掺入的困 难。实验中发现,在掺微量 So 的 GGG 晶体 中, Cr 的分凝系数仍与纯 GGG 相差不多, 在 晶体生长中很容易造成组分过冷的缺陷, 晶 体生长困难。尽管掺 Cr 的浓度降到很低,也 很难克服晶体生长中组分过冷现象的产生。 但在 GGG(Ca, Mg, Zr):(Nd, Cr)晶体中, Cr 的浓度分布就比较均匀, 在晶体生长过程 中没有组分过冷现象,长出的晶体完整透明。

分析这主要是由于 GGG(Ca, Mg, Zr): (Nd, Cr) 晶体的晶格常数(a_0 =1.250 nm)比 GGG(Se): (Nd, Cr) 的晶格常数(a_0 =1.2385 nm) 大得多。这样,Cr 在晶体生长中容易进入格位,而当晶格常数小时,不易进入格位,当过冷度稍一变化,就出现组分偏离,造成晶体中的缺陷。我们在实验中已多次观察到这种现象。另外在八面体格位由一些大离子取代 Ga后,使 Cr^{3+} 在 4T_2 — 4A_2 宽带跃迁时得到一个较低的晶体场,这样 Cr^{3+} 2E — 4T_2 的能量间隙很小(类似于 Cr^{3+} 在 GSGG 中的状况)有利于 Cr^{3+} 到 Nd^{3+} 的能量转移 Cr^{3-} 。

由图 5、6 可见,除狭窄的 Nd³⁺ 的吸收 谱线外,光谱图中显示出典型的 Cr³⁺ 的较宽 的吸收带,并复盖了大部分可见光谱区。 这样,由于 Cr³⁺ 向 Nd³⁺ 有效的能量转移,将可大大提高晶体的转换效率。另外,我们发现,随着 Cr 的浓度的增加,在吸收光谱中 Cr 的吸收峰也明显地加深。 经紫外辐照 实验发现,没有掺 Cr 和掺 Cr 浓度较低的晶体,容易产生色心。 而浓度适当加大后,色心明显减弱。

(b) 激光性能提高的可能性

目前 GGG(Ca, Mg, Zr): (Nd, Cr)晶体中 Nd 和 Cr 的浓度都掺入的不够大。晶体的光学质量也还不够好,但还是得到了0.7%的激光效率。若再从生长条件上改善工艺进一步提高晶体的光学质量,适当增加 Nd 和 Cr 的浓度,提高激光性能是完全可能的。该晶体容易生长,原材料价格适中,经进一步实验,我们认为该晶体可能成为一种很有前途的高效率激光晶体材料。

作者对物理所刘琳、林成天、陈京兰、(下转第706页)

$$CH_3 + H_2 \longrightarrow CH_4 + H$$
 (7)
 $CH_3 + CH \longrightarrow C_2H_2 + H_2$ 或 $2H$ (8)
 $CH + CH \xrightarrow{M} C_2H_2$ (9)
 $CH_2 + CH_2 \xrightarrow{M} C_2H_4$ (10)
 $CH_2 + CH_4 \longrightarrow C_2H_4 + H$ (11)
 $CH_2 + CH_3 \longrightarrow C_2H_4 + H$ (12)
 $CH_2 + CH_4 \longrightarrow C_2H_6$ (13)
 $CH_3 + CH_3 \longrightarrow C_2H_6$ (14)
 $CH_2 + C_2H_2 \longrightarrow C_3H_4$ (15)
 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$

C田+日 → CH₂ 以后的反应进程与上一过程一样。 这里 M 是第三体, C* 是碳的激发态, C* 是自由基 C₂ 的激发态。他们是激光作用于石墨表面激发 起来的, 主要是热激发。H₂ 在高温下也有可 能变成激发态或离解成 日, 但主要反应是热 表面反应。显然在反应过程中具有较高浓度 的 CH, C₂日。它们是在激光作用下得到的。 这样, 由上述反应就可以给出反应产物的定

 $CH+H_2 \longrightarrow CH_2+H$

性解释。从反应速率常数来看也应该是产物 C_2H_4 , C_2H_2 居多。反应(2)、(5)、(8)、(11)、(12)、(14)、(15)的速率常数(单位均是 cm^3 · mol^{-1} · s^{-1})分别为 $1.7 \times 10^{-11[2]}$ 、 7×10^{-12} 、 $5.3 \times 10^{-11[3]}$ 、 $3.3 \times 10^{-11[2]}$ 、 $5 \times 10^{-11[3]}$ 、 $7.5 \times 10^{-12[6]}$ 。由此看来应该有更多的 C_2H_4 , C_2H_2 产生。由于 CH_4 参与了生成 C_2H_4 、 C_2H_2 。反应(4)虽然是吸热反应[7],但 吸热不大,本实验反应区是高温区,这个反应 还是能够进行的。

参考文献

- [1] R. Schaeffer, R. K. Pearson; J. of the American Chemical Society, 1969, 91, No. 8, 2153~2154.
- [2] M. W. Bosnali, D. Perner; Z. Naturforsch, 1971, 26a, 1768.
- [3] W. Braun et al.; J. Chem. Phys., 1970, 52, 5131.
- [4] M. J. Pilling, J. A. Robertson; Chem. Phys. Lett., 1975, 23, 336.
- [5] F. C. James, J. P. Simons; Int. J. Chem. Kinet., 1974, 4, 887.
- [6] A. H. Laufer, A. M. Bass; J. Phys. Chem., 1974, 78, 1344.
- [7] 冈田秀雄;"小分子光化学",吉林人民出版社,P. 231.

(上接第713页) (加州82 州(江) 82 里)

赵满兴同志参加部分实验工作,郭照斌同志 协助化学分析,长春应化所王庆元同志协助 部分光谱测试一并表示感谢。

参 考 文 献

[1] Е. В. Жариков и др.; Кван. электр., 1983, 10, 1961.

116、110年上海0一名)11(2)

- [2] D. Pruss et al.; Appl. Phys., 1982, B28, 335.
- [3] 张乐德等;《硅酸盐学报》,1980,8,207.
- [4] 张乐潓等;《中国激光》,1984,11,347.
- [5] C. D. Brandle et al.; J. of Crystal Growth, 1973, 20, 1.
- [6] 吕学身;《激光与红外》,1984, No. 4, 25.
- [7] Е. В. Жариков и др.; Нзв. АН СССР, Сер. Физ., 1984, 48, 1330.

个脉冲),进样气压仍为 4×10-°Torr, 所得的质谱图如图 2(6)原动。全比较图图 (6)